

	<p>SIR624DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR624DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18.6A SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIR624DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIR624DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18.6A SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR624DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1110pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 7.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18.6A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18.6A (Tc)

SIR624DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR624DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR624DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR624DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR626DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 100A SO8</p>	 <p>SIR626DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIR626DP-T1-GE3 VISHAY SIR626DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIR616DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 20.2A SO8</p>
 <p>SIR622DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 51.6A SO8</p>	 <p>SIR632DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 29A SO8</p>	 <p>SIR622DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 51.6A SO-8</p>	 <p>SIR624DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18.6A SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR624DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR624DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR624DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR624DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR624DP-T1-GE3
SIR624DP-T1-GE3 Electronic	SIR624DP-T1-GE3-Komponenten	SIR624DP-T1-GE3-Verteiler	SIR624DP-T1-GE3-Bild	SIR624DP-T1-GE3-Teil
SIR624DP-T1-GE3 Preis	SIR624DP-T1-GE3 Hersteller	SIR624DP-T1-GE3 Bild	SIR624DP-T1-GE3 Aktie	SIR624DP-T1-GE3 Inventar
SIR624DP-T1-GE3 Neu	SIR624DP-T1-GE3 Original	SIR624DP-T1-GE3 garantiert	SIR624DP-T1-GE3 RFQ	SIR624DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited